

# PN7006A/B

# Chipown

## 高低侧栅驱动芯片

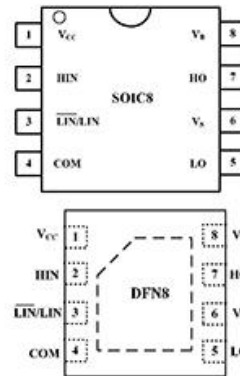
### 概述

PN7006A/B 是基于 P 衬底、P 外延的高压、高速功率 MOSFET 和 IGBT 驱动芯片。其浮地通道能工作在 120V 的高压下，可用于驱动 2 个 N 型功率 MOSFET 或 IGBT 组成的半桥结构。该芯片逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平。输出具有大电流脉冲能力。传输延时具有匹配性，以简化在高频下的应用

### 特征

- 高压范围达+120 V
- 3.3 V 逻辑兼容
- 自举工作的浮地通道
- 栅驱动电压范围 5V~20V
- 低侧欠压保护 (UVLO) 功能
- 输出拉灌电流能力 450 mA / 900mA
- 独立的逻辑输出以适应所有的拓扑结构
- 抗-5V 瞬态负  $V_s$  能力
- 高低侧通道均延时匹配
- LO/HO 与 LIN/HIN 同向 (PN7006A);  
LO 与  $\overline{LIN}$  反向; HO 与 HIN 同向 (PN7006B)

### 封装/订购信息



### 应用领域

- 中小型功率电机驱动
- 功率 MOSFET 或 IGBT 驱动

Part number	Order Code	Package
PN7006A	PN7006ASEC-R1	SOIC8
PN7006A	PN7006ADEC-R1	DFN8
PN7006B	PN7006BSEC-R1	SOIC8
PN7006B	PN7006BDEC-R1	DFN8

### 典型应用

